



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1423

对应国外型号
S1423

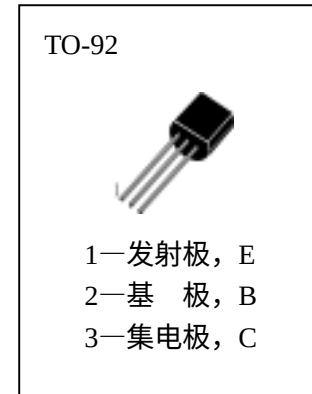
主要用途

一般用途和低噪音放大。。

极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150 $^{\circ}\text{C}$
T_j ——结温	150 $^{\circ}\text{C}$
P_C ——集电极耗散功率	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压	-40V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	-40V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	-7V
I_C ——集电极电流	-200mA I_B
——集电极电流	-200mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿压降	-40			V	$I_C=-1\text{mA}$, $I_B=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-50	nA	$V_{\text{CB}}=-30\text{V}$, $I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{\text{EB}}=-6\text{V}$, $I_C=0$
$H_{\text{FE}}(1)$	直流电流增益	70		400		$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_C=-2\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和压降			-0.22	V	$I_C=-50\text{mA}$, $I_B=-10\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极压降		-0.65		V	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_C=-2\text{mA}$
f_T	特征频率	150	300		MHZ	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_C=-10\text{mA}$
C_{ob}	输出电容			4.5	pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$